

技術の名称

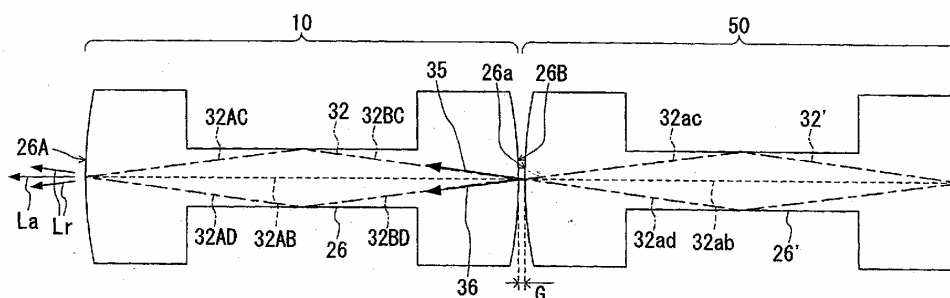
半導体レーザ装置

適用分野

光集積回路用光スイッチ、光ピックアップ用光源

- 目的 入力されたレーザ光の状態に応じて異なるレーザ光を出力する。
- 効果 本発明によれば、励起用に入射されるレーザ光によって異なったレーザ光が射出されるので、種々の光回路や光デバイスに適用できる。
- 技術概要 本発明に係る半導体レーザ装置は、レーザ光出射レーザ素子10と、励起用レーザ素子50と、から成り、レーザ光出射レーザ素子10は互いに対向する端面26Aと26Bとを有し、励起用レーザ素子50から端面26Bを介して入射されるレーザ光35および36によって、端面26Aから射出されるレーザ光LaおよびLrの強度が制御される。

■ 特記事項,図など



- 主たる提供特許 特許等の名称 : 半導体レーザ装置およびそれを用いた光集積回路
登録番号 :
出願番号 : 特願2006-041360 出願日 : 平成18年2月17日
公開番号 :
- 実施実績 有、○無 ■ 提供形態 ○実施許諾、×権利譲渡

お問合せ先 株式会社 国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 経営統括部 知的財産担当
〒619-0288 京都「けいはんな学研都市」光台二丁目2番地2
TEL 0774-95-2521 E-mail ; patent@atr.jp